

# Корпорация Intel продемонстрировала микросхемы, изготовленные по 45-нанометровой технологии

Сегодня корпорация Intel объявила о том, что она стала первой в мире компанией, которая достигла важного этапа в развитии 45-нанометровой технологии производства интегральных микросхем.

Корпорация Intel создала микросхему, которая стала первой в мире полностью работоспособной микросхемой статической памяти (SRAM, Static Random Access Memory), изготовленной по 45-нанометровой производственной технологии — новейшей технологии массового производства полупроводниковых компонентов.

Этот важный результат подтверждает планы корпорации Intel начать производство микросхем по 45-нанометровой производственной технологии с использованием 300-мм подложек в 2007 году, а также ее намерение следовать закону Мура, внедряя производственные процессы новых поколений каждые два года.

Сегодня корпорация Intel является лидером отрасли по массовому выпуску полупроводниковых компонентов с использованием 65-нанометровой производственной технологии. Две фабрики в штатах Аризона и Орегон уже работают по этой технологии, еще две фабрики — в Ирландии и штате Орегон — вступят в строй в этом году.

«Корпорация Intel первой в мире начала массовое производство микросхем по 65-нанометровой технологии. Мы также первыми выпустили работоспособную микросхему, изготовленную с использованием 45-нанометровой технологии. Эти факты подчеркивают лидерство корпорации Intel в технологической и производственной сферах, — подчеркнул Билл Хоулт (Bill Holt), вице-президент и главный менеджер подразделения Technology and Manufacturing Group корпорации Intel. — Корпорация Intel славится богатой историей технологических инноваций, внедрение которых приносит ощутимую пользу людям. Наша 45-нанометровая технология обеспечит базу для производства ПК с улучшенным соотношением производительности на один ватт потребленной электроэнергии, которые принесут новые возможности для пользователей».

45-нанометровая производственная технология Intel позволит выпускать микросхемы, ток утечки в которых снижен более чем в пять раз по сравнению с микросхемами, выпускающимися сейчас. Это позволит увеличить время автономной работы мобильных устройств, а также открыть новые возможности для создания компактных платформ с расширенной функциональностью.

Микросхема статической памяти, изготовленная по 45-нанометровой производственной технологии, содержит более 1 миллиарда транзисторов. Несмотря на то, что устройство не является конечной продукцией, оно демонстрирует эффективность технологии, работоспособность процесса и надежность микросхем в преддверии выпуска процессоров и других интегральных микросхем по 45-нанометровой производственной технологии. Это первый и очень важный шаг в направлении организации массового производства самых сложных электронных устройств в мире.

Ранее корпорация Intel объявила о том, что кроме фабрики D1D в штате Орегон, где были проведены начальные работы по разворачиванию 45-нанометрового производственного процесса, строятся еще две фабрики по массовому производству микросхем по 45-нанометровой производственной технологии: Fab 32 в штате Аризона и Fab 28 в Израиле.

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:  
[newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)  
эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)  
эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)